

トランジスタ

2SC1980

2SC1980

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

高耐圧・低雑音増幅用 / High Voltage, Low-noise Amplifier
2SA921 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SA921

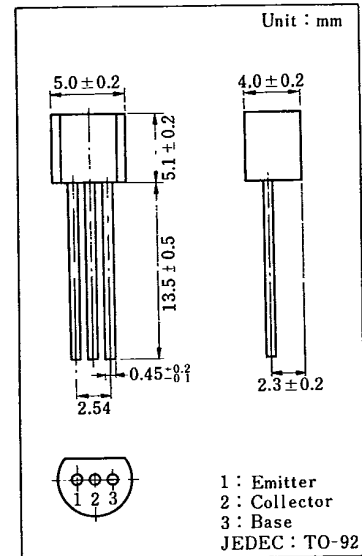
■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ電圧 V_{CE0} が高い。 / High V_{CE0}
- 雑音電圧 NV が低い。 / Low NV

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	50	mA
コレクタ電流	I_C	20	mA
コレクタ損失	P_C	400*	mW
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*ポットイングタイプは $P_C = 250\text{mW}$ / Potting type : $P_C = 250\text{mW}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 50\text{V}, I_E = 0$			100	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = 50\text{V}, I_B = 0$			1	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 10\mu\text{A}, I_E = 0$	120			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$	120			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10\mu\text{A}, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 2\text{mA}$	180		1040	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20\text{mA}, I_B = 2\text{mA}$			0.6	V
雑音電圧	NV	$V_{CE} = 40\text{V}, I_C = 1\text{mA}, G_V = 80\text{dB}$ $R_g = 100\text{k}\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$			150	mV

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	R	S	T	U
h_{FE}	180 ~ 360	260 ~ 520	360 ~ 700	520 ~ 1040

トランジスタ

T-29-15

2SC1980

